

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第6073828号
(P6073828)

(45) 発行日 平成29年2月1日(2017.2.1)

(24) 登録日 平成29年1月13日(2017.1.13)

(51) Int.Cl.	F I
HO4R 19/00 (2006.01)	HO4R 19/00 330
A61B 8/00 (2006.01)	A61B 8/00
GO1N 29/24 (2006.01)	GO1N 29/24
BO6B 1/06 (2006.01)	BO6B 1/06 Z

請求項の数 8 外国語出願 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2014-77629 (P2014-77629)	(73) 特許権者	590000248
(22) 出願日	平成26年4月4日 (2014.4.4)		コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
(62) 分割の表示	特願2010-537594 (P2010-537594) の分割		KONINKLIJKE PHILIPS N. V.
原出願日	平成20年12月12日 (2008.12.12)		オランダ国 5656 アーエー アイン ドーフエン ハイテック キャンパス 5
(65) 公開番号	特開2014-200089 (P2014-200089A)		High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven
(43) 公開日	平成26年10月23日 (2014.10.23)		
審査請求日	平成26年4月24日 (2014.4.24)	(74) 代理人	100087789
(31) 優先権主張番号	61/013, 716		弁理士 津軽 進
(32) 優先日	平成19年12月14日 (2007.12.14)	(74) 代理人	100122769
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 笛田 秀仙
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 輪郭成形基板を含む崩壊モードで動作可能な c M U T

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板、及び
柔軟膜

を有する容量性超音波トランスデューサにおいて、

前記柔軟膜は、当該柔軟膜がそれに沿って前記基板に取り付けられている周辺領域、及び前記周辺領域間を延在している中央領域を有し、並びに

前記基板は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が前記中央領域の付近において前記基板に崩壊するように輪郭成形され、それにより前記トランスデューサは、減少したバイアス電圧又はバイアス電圧無し of のどちらか一方で崩壊モードで動作することを可能にする容量性超音波トランスデューサ。

10

【請求項 2】

前記周辺領域の各々の付近において、前記基板と前記柔軟膜との間に崩壊していない間隙が存在している請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサ。

【請求項 3】

前記基板は、前記中央領域の付近における崩壊地点を乗り越して前記柔軟膜を引っ張るように輪郭成形される請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサ。

【請求項 4】

前記基板は、前記中央領域の付近において約 2 μ m までの範囲で前記柔軟膜と機械的に干渉するように輪郭成形される請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサ。

20

【請求項 5】

前記基板は、前記中央領域の付近において約 $1 \sim 6 \mu\text{m}$ までの範囲で前記柔軟膜と機械的に干渉するように輪郭成形される請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサ。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサを有する医療撮像システム。

【請求項 7】

共通の基板上に置かれる請求項 1 に記載の容量性超音波トランスデューサのアレイを有する医療撮像システム。

【請求項 8】

基板及び柔軟膜を有するトランスデューサを供給するステップであり、前記柔軟膜は、当該柔軟膜がそれに沿って前記基板に取り付けられる周辺領域、及び前記周辺領域間を延在している中央領域を有し、前記基板は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が前記中央領域の付近において前記基板に崩壊するように輪郭成形されるステップ、並びに

バイアス電圧がないと、前記トランスデューサを前記崩壊モードで動作させるステップを有する容量性超音波トランスデューサを動作させる方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本開示は、医療診断画像を生成するためのシステム及び方法を対象とし、特に超音波トランスデューサを対象としている。

【背景技術】

【0002】

Bayram, B. 共著、A New Regime for Operating Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers, IEEE Trans UFFC, Vol. 50, No.9(2003)に述べられるように、崩壊モード (collapsed mode) で動作すべき従来の容量性超音波トランスデューサ (cMUT: capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer) にとって、この cMUT の柔軟膜 (flexible membrane) は、この膜の一部を対応する cMUT 基板に崩壊させる電圧を用いて一般に励起される。次いで、この膜に印加される電圧を、cMUT の "スナップバック電圧 (snapback voltage)" として一般に特徴付けられる、一定のしきい電圧に減少することは、この膜を基板から上に持ち上げたり、平衡位置まで戻したりする。一方、先に崩壊した膜に印加される電圧が前記スナップバック電圧より上に維持される範囲内で、前記装置のかなり線形且つ効率的な出力が一般に達成されることができ。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

従来の cMUT 構造が図 1 に示される。特に、図 1 は、ポケット 104 を形成する基板 102、及びこのポケット 104 にまたがって前記基板 102 に取り付けられる柔軟膜 106 を有する cMUT 100 を断面図で示す。この柔軟膜 106 と基板 102 とに印加されるバイアス電圧がかなり低い電圧又は零ボルトに設定される状況において、cMUT 100 は一般的に、柔軟膜 106 と基板 102 との間にあるポケット 104 内に間隙 108 を表す。

【0004】

ここで図 2 を参照すると、動作時、図 1 に示される cMUT 100 の形状と関連するかなり低い又は零のレベルから十分な量を増大する電圧バイアスを、前記柔軟膜 106 と基板 102 とに印加する際、この柔軟膜 106 は、ポケット 104 の下方へ及び基板 102 に向かって崩壊する傾向がある。柔軟膜 106 のこのような崩壊は、柔軟膜 106 の下向き面 200 が基板 102 の対応する上向き面 202 と物理的に接触して少なくとも一時的に置かれるように、柔軟膜 106 と基板 102 との間にある前記間隙 108 (図 1 参照) を殆ど除去することができる。一旦そうなると、基板 102 に関して柔軟膜 106 のこの崩壊状態は、一般に "スナップバック" 電圧とも呼ばれる、一定の最小レベルを超えるバイ

10

20

30

40

50

アス電圧を、柔軟膜 106 及び基板 102 に連続して印加することにより維持される。

【0005】

c M U T 100 は崩壊モードで使用され、圧力波を放射又は受信する。柔軟膜 106 が基板 102 に崩壊した状態で圧力波を放射する c M U T 100 に対し、柔軟膜 106 と基板 102 とにかかる電圧は、かなり高い電圧とかなり低い電圧との間を循環する。このような両方の電圧は一般に、それら電圧の夫々の大きさに関し、c M U T 100 に関連するスナップバック電圧よりも高い。かなり高い電圧及びかなり低い電圧のうち、かなり高い電圧は、柔軟膜 106 の下向き面 200 と基板 102 の上向き面 202 との間にある、それに応じて大きくなる接触エリアに関連する。柔軟膜 106 が誘導、駆動される、又は他の方法で、循環するバイアス電圧により、基板 102 と物理的に接触している上記大きい及び小さなエリア間を交互に起こさせるので、柔軟膜 106 の一定の部分は、ポケット 104 内において基板 102 の対応する部分に関して垂直方向に往復運動することにより、基板 102 と接するエリアに及びそのエリアから（例えば柔軟膜 106 の"崩壊領域"に及び"崩壊領域"から）遷移する。柔軟膜 106 の上記遷移部分の上記往復垂直運動が所望の圧力波を生み出す。当業者は分かっているように、上記 c M U T 100 は一般に、c M U T 100 により受信される外部で生じた圧力波に曝されている柔軟膜 106 に応じて、対応する電気信号を生成及び送信するために、図 2 に示される崩壊モードで使用することも可能である。

【0006】

例えば図 1 及び図 2 の c M U T 100 のような、c M U T の効率の少なくとも 1 つの共通する方法に従って、（例えば電気入力に応じて出力として）圧力波の放射に、及び / 又は電気出力を生成する処理の一部として、入力として）入射する圧力波の受信及びその圧力波の応答に、実質的に積極的に加わる前記柔軟膜のその部分の大きさ又はエリアの値は、比較のために少なくとも 1 つの基準を供給する。例えば、同じ入力電気信号又は同じ入力圧力波に対し少なくとも幾分か異なって応答する傾向がある c M U T 100 の 2 つの少なくとも幾分か異なって構成される変数の場合、柔軟膜 106 の崩壊領域のより大きな動きを示している c M U T 変数がより効率的な装置であると通常は見なされる。

【0007】

今日までの努力にもかかわらず、効率的及び効果的な c M U T の装置及び方法、並びにこの装置の使用方法に対する必要性が残っている。これら及び他の必要性は、以下の詳細な説明から明らかとなるように、開示される装置、システム及び方法により満たされる。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本開示の実施例に従って、容量性超音波トランスデューサが供給され、このトランスデューサは、基板及び柔軟膜を有し、前記柔軟膜は、この柔軟膜がそれに沿って前記基板に取り付けられている周辺領域、及びこれら周辺領域間を延在している中央領域を有する。前記トランスデューサの基板は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が前記中央領域付近において基板に崩壊するように輪郭成形され、それにより前記トランスデューサは、減少したバイアス電圧又はバイアス電圧無しのどちらか一方で崩壊モードで動作することを可能にする。前記周辺領域の各々の付近において、前記基板と前記柔軟膜との間に崩壊していない間隙(non-collapsible gap)が存在している。この基板は例えば、前記中央領域の付近における崩壊地点を通り越して柔軟膜を引っ張る及び / 又は前記中央領域の付近において約 2 μm までの範囲（例えば約 1 . 6 μm までの範囲）で前記柔軟膜と機械的に干渉するように輪郭成形される。前記基板は、柔軟膜の下に置かれる他の膜を含み、この他の膜は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が中央領域の付近において前記他の膜に崩壊するように輪郭成形される。前記柔軟膜の長さ及び厚さは夫々、約 80 μm （例えば約 100 μm ）よりも大きく、約 3 μm （例えば約 2 μm ）よりも小さく、並びに前記他の膜は少なくとも約 4 μm の厚さ（例えば約 5 μm の厚さ）である。前記基板はさらに、前記他の膜の下に置かれる支持体を含み、この支持体は、支持体と柔軟膜との間にある本来の間隙の厚さに少なくとも等しい範囲まで前記柔軟膜に向かい上向きに前記他の膜の対応する

部分をそらせるように寸法がとられる及び構成される。前記支持体は、前記他の膜の下に置かれると共に、前記柔軟膜の中央領域と垂直方向に位置合わせされた柱でもよいし、及び／又は前記柔軟膜の中央領域と垂直方向に位置合わせされた他の膜の中心部以外の他の膜の領域の下では構造上不完全でもよい。前記支持体は、少なくとも約 $0.5\ \mu\text{m}$ の範囲（例えば、約 $0.9\ \mu\text{m}$ から約 $2.5\ \mu\text{m}$ の間の範囲）まで垂直方向上向きに、前記柔軟膜の中央領域と垂直方向に位置合わせされた前記他の膜の中心部をそらせるように動作させる一方、前記他の膜の少なくとも1つの相対的な周辺部は実質的に垂直方向にはそらないままにすることを可能にする。前記基板は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が前記中央領域の付近において基板に崩壊するように輪郭成形され、これにより前記トランスデューサは、同等に輪郭成形されていない基板を示している他の点では同等の従来のトランスデューサと比べて、改善された効率 (k_{eff}^2) で崩壊モードで動作することを可能にする。

10

【0009】

本開示の実施例に従って、容量性超音波トランスデューサを有する医療撮像システムが供給され、このトランスデューサは、基板及び柔軟膜を有し、前記柔軟膜は、この柔軟膜がそれに沿って前記基板に取り付けられる周辺領域、及びこれら周辺領域間を延在している中央領域を有する。前記トランスデューサの基板は、バイアス電圧がないと、前記中央領域の付近において基板に崩壊するように輪郭成形され、それにより前記トランスデューサは、減少したバイアス電圧又はバイアス電圧無しのどちらか一方で崩壊モードで動作することを可能にする。前記医療撮像システムは共通の基板上に置かれる上記トランスデューサのアレイを有する。

20

【0010】

本開示の実施例に従って、容量性超音波トランスデューサを動作させる方法が供給され、この方法は、基板及び柔軟膜を含むトランスデューサを供給するステップ及びバイアス電圧がないと、前記トランスデューサを崩壊モードで動作させるステップを有し、前記柔軟膜は、この柔軟膜がそれに沿って前記基板に取り付けられる周辺領域、及び前記周辺領域間を延在している中央領域を有し、前記基板は、バイアス電圧がないと、前記柔軟膜が前記中央領域の付近において前記基板に崩壊するように輪郭成形される。

【図面の簡単な説明】

【0011】

30

【図1】従来のcMUTを示す図である。

【図2】崩壊の動作モードの図1のcMUTを示す図である。

【図3】本発明の実施例に従って構成されるcMUTを示す図である。

【図4】本発明の実施例に従って図3のcMUTを製造する方法を示す図である。

【図5】本発明の実施例に従って図3のcMUTを製造する方法を示す図である。

【図6】本発明の実施例に従って図3のcMUTを製造する方法を示す図である。

【図7】本発明の実施例に従って図3のcMUTを製造する方法を示す図である。

【図8】ある従来技術の、しかし他の同等なcMUTと比べて、本発明に従うcMUTの様々な実施例に対応する効率データをバイアス電圧の関数として示す図である。

【図9】ある従来技術の、しかし他の同等なcMUTと比べて、本発明に従うcMUTの様々な実施例に対応する効率データをバイアス電圧の関数として示す図である。

40

【図10】本発明に従って構成されるcMUT装置のアレイを含む、本発明の実施例に従う医療診断画像を生成するためのシステムを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0012】

当業者が開示される装置、システム及び方法を作成及び使用すること支援するために、付随する図面に参照番号が付けられる。

【0013】

cMUTを崩壊モードで使用することの従来ある欠点の1つは、崩壊電圧が一般に動作電圧よりもかなり高いことであり、故に高電圧回路が必要とされることである。加えて、

50

出力は通常、上記装置の如何なる効率の改善も望ましいような撮像応用における c M U T の制限要因である。

【 0 0 1 4 】

これら応用は、モデリング及びシミュレーションによって、c M U T の基板表面にある変更を実施することが崩壊モードでの動作において効率の改善となり得ることが分かる。本開示の幾つかの実施例において第 2 の膜を含む基板は、c M U T の前記柔軟膜の中央に間隙を持たないように輪郭成形（バイアスの無い崩壊モード）される。これは、本開示に従う c M U T がバイアス電圧無し（又は小さなバイアス電圧）で崩壊モードで動作することを可能にする。その上、これら応用は、本開示による c M U T が、前記基板が接点（崩壊）を通り越して前記膜を引っ張るのに用いられたとき、効率が増大するのが示される。この効率の改善に加え、本開示に従う c M U T は、必要な電圧をかなり下げることが可能にする。他の関連する利点の中で、このような改善は、本開示に従う c M U T を主流の超音波プローブに取り入れるのにかなり適している。

【 0 0 1 5 】

図 3 に戻ってみると、本開示の例示的な実施例に従う c M U T 装置が示される。特に、図 3 は、c M U T 3 0 0 を断面図で示す。この c M U T 3 0 0 は、ポケット 3 0 4 を形成する基板 3 0 2 を含む。c M U T 3 0 0 はさらに、前記ポケット 3 0 4 にまたがって前記基板 3 0 2 に結合される柔軟膜 3 0 6 を含む。この柔軟膜 3 0 6 は、夫々の周辺領域 3 0 8 を含み、前記柔軟膜 3 0 6 は、この領域に沿ってポケット 3 0 4 の対応する周辺部の周辺又は辺りで基板 3 0 2 に取り付けられる。柔軟膜 3 0 6 はさらに、前記周辺領域 3 0 8 の間を延在している中央領域 3 1 0 を含む。またさらに、柔軟膜 3 0 6 は、下向き面 3 1 2 を規定している。基板 3 0 2 はさらに、前記ポケット 3 0 4 の周辺部内に置かれる基板 3 1 4 を含んでもよい。この基板 3 1 4 は、上向き輪郭成形表面 3 1 6 を規定及び / 又は少なくとも構造的に支持してもよい。この上向き輪郭成形表面 3 1 6 は、前記中央領域 3 1 0 の付近において前記柔軟膜 3 0 6 の下向き表面 3 1 2 と接する及び / 又は他の方法で協働して嵌合するために、ポケット 3 0 4 の上向き又は外向きに延在又は突出する。前記輪郭成形表面 3 1 6 は、少なくとも弓形、湾曲、凸形及びドーム形のうち 1 つ以上である。前記輪郭成形表面 3 1 6 の他の形状も可能である。前記輪郭成形表面 3 1 6 は、輪郭成形表面がポケット 3 0 4 内に略完全に含まれる又は閉じ込められよう、（例えば図 3 の用紙に対して垂直に配される方向に沿って）十分に小さい若しくは短い横方向及び / 又は深さ方向の範囲を規定する又は含んでもよい。例えば、前記輪郭成形表面 3 1 6 は、柔軟膜 3 0 6 の中央領域 3 1 0 と専ら干渉するために、ポケット 3 0 4 内において略孤立した "島" を有する又は規定するように、寸法がとられる及び構成されてもよい（例えば前記輪郭成形表面は、周辺領域 3 0 8 の付近において、対応して減少する輪郭を規定するか又はこの周辺領域 3 0 8 の付近には殆ど無いかの何れか一方である）。前記輪郭成形表面 3 1 6 の横方向及び / 又は深さ方向の範囲に対する他の幾何学的及び / 又は寸法上の構成も可能である。

【 0 0 1 6 】

本開示の、特に図 3 に示されるような実施例に従って、前記輪郭成形表面 3 1 6 の少なくとも一部又はセグメントは、基板 3 0 2 の基準高度 3 2 0 に対する高度 3 1 8 を占め、前記柔軟膜 3 0 6 の周辺領域 3 0 8 の 1 つ以上に関連する下向き表面 3 2 2 の少なくとも一部又はセグメントは、同じ基準高度 3 2 0 に対する高度 3 2 4 を占め、前記高度 3 1 8 は、前記基準高度 3 2 0 に対し高度 3 2 4 よりも少なくとも幾分か高い。例えば、前記基板 3 0 2 に対する柔軟膜 3 0 6 の基本高度は、輪郭成形表面 3 1 6 と柔軟膜 3 0 6 との間に如何なる干渉もないと、柔軟膜 3 0 6 の下向き表面 3 1 2 の全範囲は前記高度 3 2 4 と略横方向に並べられる及びその高度に位置決められる傾向であるように、高度 3 2 4 において共通の高度を占めている前記柔軟膜の周辺領域 3 0 8 の全てによって設定されてもよい。このような状況において、柔軟膜 3 0 6 の前記基本高度 3 2 4 よりも少なくとも幾分か高い、高度 3 2 0 の基板 3 0 2 の輪郭成形表面 3 1 6 の少なくとも一部又はセグメントによる占有は、前記輪郭成形表面 3 1 6 と柔軟膜 3 0 6 の下向き表面 3 1 2 との間に機械

的な干渉を生じさせる。同様に、前記柔軟膜 306 は、前記輪郭成形表面 316 及び / 又は構造体 314 により上向きにそらし、中央領域 310 の付近において前記輪郭成形表面 316 を前記柔軟膜 306 と常に接したままにさせるプレロード(pre-load)をもたらす。

【0017】

本開示に従って、図 3 において別々には示されていない若しくは表示されていない、c M U T 300 に関連する電極の特定の性質、構成又は配置が必ずしも重要ではない。それ自体は、c M U T に一般に応用可能である電極構成の改善若しくは最適化の形式又は方法が c M U T 300 に特に応用されてもよい。

【0018】

図 3 に示されるように、c M U T 300 の一部として含まれる構造体 314 は、ポケット 304 の略中心に置かれ、その場所において柔軟膜 306 の方向に上向きに延在している柱 326、並びにこの柱 326 の上に及び柱にまたがって含んでいる、ポケット 304 内に置かれると共に、ポケット 304 に広がって延在する下方膜 328 を含む。上述した及びここにさらに説明されるように、構造体 314 及びこの構造体に関連する輪郭成形表面 316 は、崩壊モードの c M U T 300 を平衡位置（例えば零（0）ボルトのバイアス電圧）に置く。前記下方膜 328 は、（この下方膜 328 の運動が必ずしも放射圧力波を生じさせない）基板 302 へのエネルギー損失を参照するために、柔軟膜 306 よりもかなり厚い及び / 又は堅くてもよい。本開示の実施例に従って、柔軟膜 306 の長さ及び厚さは夫々約 100 μm 及び 2 μm であり、前記下方膜 328 は約 5 μm の厚さでもよい。柱 326 の頂部の高さは、初期間隙の厚さ（変形していない膜）に約 1.6 μm を加えたのに対応する寸法に設定される。柔軟膜 306 の長さ及び厚さ、下方膜 328 の厚さ、並びに柱 326 の頂部の高さに対する他の寸法及び / 又は関連する寸法の組み合わせが可能であり、本開示の実施例に従って、同様の増強効果を達成するのに用いられてもよい。

【0019】

さらに、本開示の例示的な実施例に従って、c M U T 300 は、様々な処理及び製造技術の 1 つ以上を用いて組み立てられる。例えば、図 4、5、6 及び 7 に描かれるように、c M U T 300 を組み立てる 1 つの上記方法が論じられている。S O I ウエハー (SOI wafer) は、図 4 に示されるような二重膜構造を持つ基板を製造するのに用いられる。もう 1 つのウエハーは、図 5 に示されるような柱構造を持つ基板を製造するのに用いられる。これら 2 つのウエハーは、位置合わせされ、一緒に接続されて、図 6 にある構造体を製造する。二重膜構造の基板が取り除かれ、図 7 に示されるような最終構造を与えてもよい。

【0020】

本出願人は、図 3 に関して示される及び上述される c M U T 300 の効率 (k^2_{eff}) を図 2 に示される従来の崩壊した c M U T 100 の効率と比較するために、モデリング及びシミュレーションを行った。図 8 は、この比較を 0.5 から 1.3 μm の範囲を持つ初期間隙の厚さの関数として示す（これらの場合、柱の高さは初期間隙の厚さに 1.6 μm を加えている）。c M U T 300 は、前記間隙の厚さの全てに大幅な効率の増大を示し、大きな間隙に対しては大きさを 2 倍にすることができる。本出願人はさらに、図 9 に示されるように、初期間隙の厚さから初期間隙の厚さに 1.6 μm を加えた厚さまでの柱の高さの変化を調べた（初期間隙の厚さが 0.9 μm である）。0.9 μm の柱の高さ（初期間隙の厚さ）は、下方膜 328 をちょうど柔軟膜 306 との接点まで上げ、前記二重膜構造の（小さな電圧範囲にわたる）効率の僅かな増大を示し、これは、柱の高さが上がるにつれて増大する。

【0021】

二重膜構造は、本開示に従って改善された効率を持つ c M U T を達成する 1 つのやり方である。この二重膜構造のような基板形状を生じさせる如何なる処理も高い効率を持つべきである。この改善された効率は、c M U T 300 の（相互的な）送信及び受信機能の両方を達成すべきである。

【0022】

例えば c M U T 300 のような装置に上手く適した応用は、医療超音波システム用の大

10

20

30

40

50

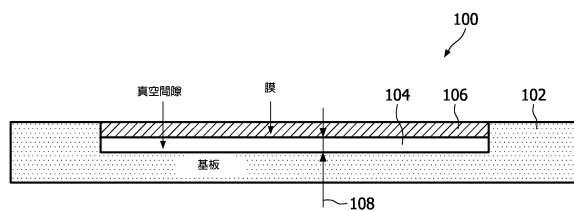
きなアレイを含む。本開示の例示的な実施例に従って、上記医療超音波システムは、図 10 に描かれるシステム 1000 のような 1 つ以上のシステムを含んでもよい。このシステム 1000 は、示される 2 つの c M U T 300 を含んでいるが、必ずしもこれに限定されない本開示に従う c M U T 装置のアレイを含む。特に示される c M U T 300 を含む上記 c M U T 装置は、本開示と一致する増強した機能性及び性能特性をシステム 1000 に供給する、例えば大きな 2 D アレイのようなアレイで集合化されてもよい。大きな形状因子は、c M U T 300 が従来のシリコン処置を用いて製造される限り、成し遂げられる。加えて、本開示の実施例に従って、駆動電子機器がシステム 1000 のトランスデューサと一体化されてもよい。

【 0 0 2 3 】

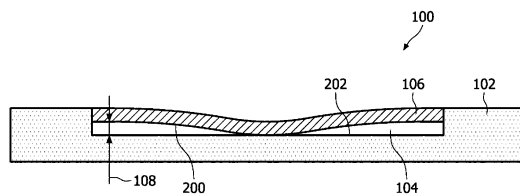
開示される装置、システム及び方法は、本開示の意図又は範囲から外れることなく、多くの他の変形例及び代替のアプリケーションの余地がある。

10

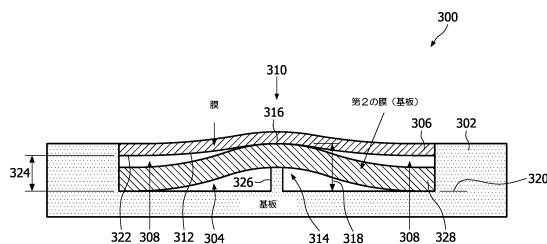
【 図 1 】



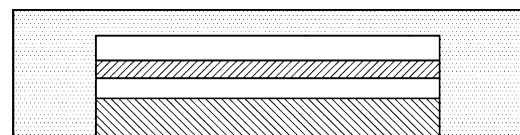
【 図 2 】



【 図 3 】



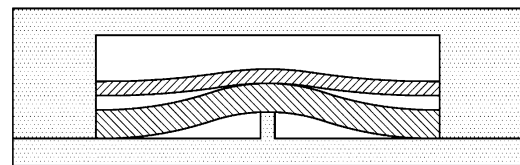
【 図 4 】



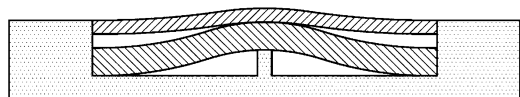
【 図 5 】



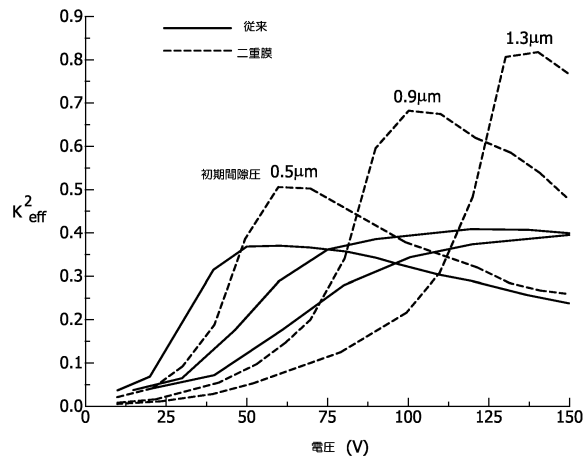
【 図 6 】



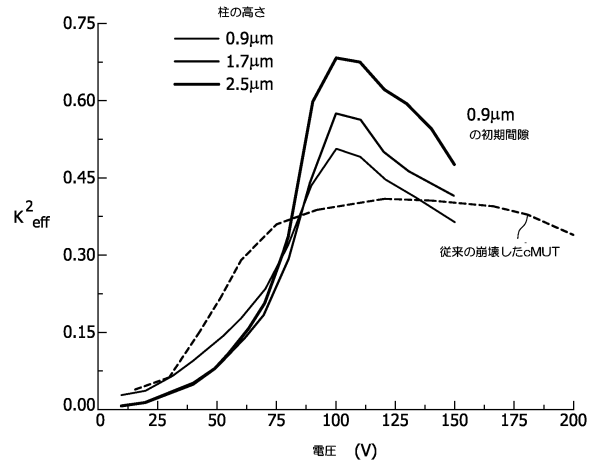
【 図 7 】



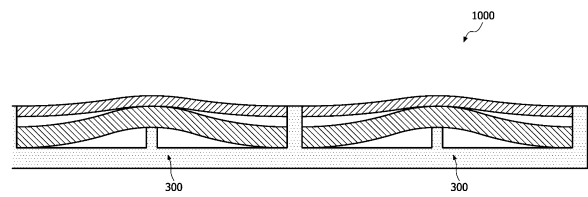
【図 8】



【図 9】



【図 10】



フロントページの続き

(74)代理人 100163809

弁理士 五十嵐 貴裕

(72)発明者 ペトルツェッロ ジョン

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 ブリアクリフ マノアー 345 ス
カボロー ロード ピーオー ボックス 3001

(72)発明者 フレイザー ジョン ダグラス

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 ブリアクリフ マノアー 345 ス
カボロー ロード ピーオー ボックス 3001

(72)発明者 チョウ シーウェイ

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 ブリアクリフ マノアー 345 ス
カボロー ロード ピーオー ボックス 3001

(72)発明者 デュフォルト ベノワ

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 ブリアクリフ マノアー 345 ス
カボロー ロード ピーオー ボックス 3001

(72)発明者 レタヴィック テオドール ジェイムス

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 ブリアクリフ マノアー 345 ス
カボロー ロード ピーオー ボックス 3001

審査官 大野 弘

(56)参考文献 特許第5833312(JP, B2)

米国特許出願公開第2006/0004289(US, A1)

特開2006-020313(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H04R 19/00

A61B 8/00

B06B 1/06

G01N 29/24

H04R 19/00

A61B 8/00

B06B 1/06

G01N 29/24

专利名称(译)	可在折叠模式下操作的cMUT，包括成型基板		
公开(公告)号	JP6073828B2	公开(公告)日	2017-02-01
申请号	JP2014077629	申请日	2014-04-04
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦NV哥德堡		
当前申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦NV哥德堡		
[标]发明人	ペトルツェロジョン フレイザージョンダグラス チョウシーウェイ デュフォルトベノワ レタヴィックテオドルジェイムス		
发明人	ペトルツェロ ジョン フレイザー ジョン ダグラス チョウ シーウェイ デュフォルト ベノワ レタヴィック テオドル ジェイムス		
IPC分类号	H04R19/00 A61B8/00 G01N29/24 B06B1/06		
CPC分类号	B06B1/0292		
FI分类号	H04R19/00.330 A61B8/00 G01N29/24 B06B1/06.Z G01N29/34		
F-TERM分类号	2G047/BC13 2G047/CA01 2G047/EA05 2G047/GB11 2G047/GB32 4C601/EE03 4C601/GB02 4C601/GB41 5D019/DD01 5D107/AA03 5D107/BB07 5D107/CC01 5D107/FF05		
审查员(译)	大野 弘		
优先权	61/013716 2007-12-14 US		
其他公开文献	JP2014200089A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

种类代码：A1仍然需要一种有效且有效的cMUT设备和方法，以及使用该设备的方法。提供了一种电容式超声换能器，其可在收缩模式下操作，具有降低的偏压或无偏压。换能器具有基板，其轮廓使得在没有偏压的情况下，柔性膜的中心区域塌陷到基板中。在基底和柔性膜的周边区域之间存在未塌陷的间隙。基底的轮廓是将柔性膜拉过塌陷点或机械地干扰柔性膜。基底具有放置在柔性膜下方的另一个膜，另一个膜具有轮廓，使得柔性膜塌陷到该另一个膜中。基底可以是放置在另一个膜下方的支撑件，以便将另一个膜的相应部分向上朝向柔性膜偏转。支持可以是列。点域

(19) 日本国特許庁(JP)	(12) 特 許 公 報(B2)	(11) 特許番号 特許第6073828号 (P6073828)
(45) 発行日 平成29年2月1日(2017.2.1)	(24) 登録日 平成29年1月13日(2017.1.13)	
(51) Int. Cl. H04R 19/00 (2006.01) A61B 8/00 (2006.01) G01N 29/24 (2006.01) B06B 1/06 (2006.01)	FI H04R 19/00 330 A61B 8/00 G01N 29/24 B06B 1/06 Z	
請求項の数 8 外国語出願 (全 9 頁)		
(21) 出願番号 特願2014-77629 (P2014-77629) (22) 出願日 平成26年4月4日(2014.4.4) (62) 分割の表示 特願2010-537594 (P2010-537594)の分割 原出願日 平成20年12月12日(2008.12.12) (65) 公開番号 特開2014-200089 (P2014-200089A) (43) 公開日 平成26年10月23日(2014.10.23) 審査請求日 平成26年4月24日(2014.4.24) (31) 優先権主張番号 61/013,716 (32) 優先日 平成19年12月14日(2007.12.14) (33) 優先権主張国 米国(US)	(73) 特許権者 590000248 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ KONINKLIJKE PHILIPS N. V. オランダ国 5656 アーエー アイン ドーフエン ハイテック キャンパス 5 High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven (74) 代理人 100087789 弁理士 津 龍 達 (74) 代理人 100122769 弁理士 前田 秀仙	
最終頁に続く		
(54) 【発明の名称】 輪郭成形基板を含む共振モードで動作可能なcMUT		